



NEW!

CE

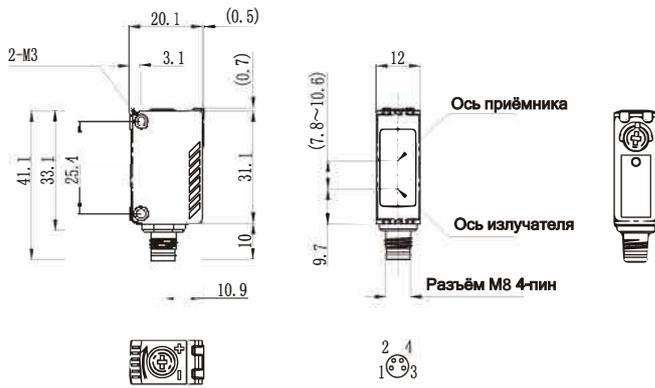
Принцип работы	Фотоэлектрический датчик			
Форм-фактор корпуса	Прямоугольный			
Принцип работы оптики	Подавление фона, диффузное отражение			
Рабочий диапазон	5~100 мм	5~150 мм	5~300 мм	5~300 мм
Настраиваемое расстояние	25-100 мм	25~150 мм	25~300 мм	25~300 мм
Размер светового пятна	Около 6*65 мм (на 100 мм)	Около Ø3 мм (на 150 мм)	Около Ø8 мм (на 300 мм)	Около Ø16 мм (на 300 мм)
Источник света	Красный модулированный светодиод 630 нм	Красный модулированный светодиод 660 нм		Красный модулированный светодиод 630 нм
Индикатор состояния	Индикатор работы: зеленый; Индикатор события: красный			
Настройка чувствительности	6-оборотный потенциометр			
Режим переключения	переключение светло/темно			
Режим работы выхода	NPN или PNP, открытый коллектор			
Время отклика	≤1 мс			
Частота переключения	≤500 Гц			
Повторяемость	≤5%Sr			
Гистерезис	≤ 5%(белая матовая бумага)			
Рабочее напряжение	10~30В постоянного тока ±10%			
Потребление питания	≤20 мА			
Остаточное напряжение	< 1.5В (ток нагрузки ≤1 00 мА)			
Ток нагрузки	≤1 00 мА (30В постоянного тока)			
Сопротивление изоляции	Сопротивление изоляции между клеммой питания и корпусом 20 МОм (500 В постоянного тока)			
Выдерживаемое напряжение	1000 В переменного тока (50/60 Гц)			
Защита контура	Защита от переплюсовки, избыточного напряжения и короткого замыкания			
Рабочая температура	-25°C~+55°C (без наледи)			
Температура хранения	-30°C~ 70(без наледи)			
Рабочая влажность	35~85% относительной влажности (без конденсации)			
Влажность хранения	35~95% относительной влажности (без конденсации)			
Внешнее освещение	Лампа накаливания ≤ 3000 люкс; светодиоды ≤600 люкс; солнечный свет ≤ 1 0000 люкс			
Устойчивость к вибрации	10~50 Гц, амплитуда 0,5 мм, 2 часа по осям X/Y/Z			
Класс защиты	IP67			
Макс. усилие затяжки	≤0.5Н			
Тип подключения	Разъём M8 4-пин			
Габариты	31*20*11 мм			
Материал	ПК+АБС (корпус); ПММА (линза)			
Вес	Около 10 г			
Аксессуары	Отвертка, крепёж, винты и гайки			
NPN	ESB-BL10ANE	ESB-BS15ANE	ESB-BS30ANE	ESB-BE30ANE
PNP	ESB-BL10APE	ESB-BS15APE	ESB-BS30APE	ESB-BE30APE



NEW!

CE

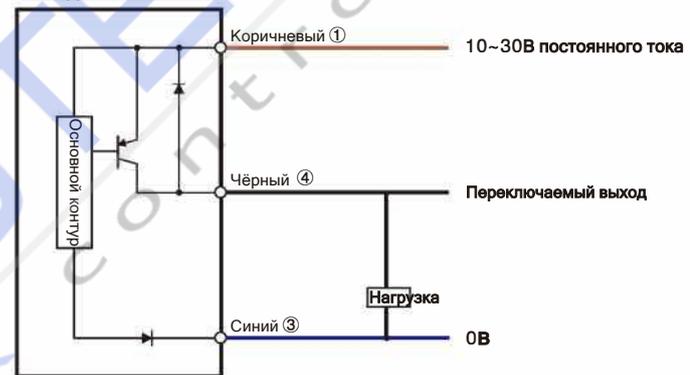
Принцип работы	Фотоэлектрический датчик	
Форм-фактор корпуса	Прямоугольный	
Принцип работы оптики	Подавление фона, диффузное отражение	
Рабочий диапазон	5~300 мм	5~300 мм
Настраиваемое расстояние	25~300 мм	25~300 мм
Размер светового пятна	ИК диод (около Ø16мм на 300 мм)	Около Ø18 мм (на 300 мм)
Источник света	Модулированный ИК диод 940 нм	Модулированный синий диод 470 нм
Индикатор состояния	Индикатор работы: зеленый; Индикатор события: красный	
Настройка чувствительности	6-оборотный потенциометр	
Режим переключения	переключение светло/темно	
Режим работы выхода	NPN или PNP, открытый коллектор	
Время отклика	≤7 мс	
Частота переключения	≤500 Гц	
Повторяемость	5%Sr	
Гистерезис	5% (белая матовая бумага)	
Рабочее напряжение	10~30В постоянного тока ±10%	
Потребление питания	≤20 мА	
Остаточное напряжение	≤1.5В (ток нагрузки ≤100 мА)	
Ток нагрузки	≤100 мА (30В постоянного тока)	
Сопротивление изоляции	Сопротивление изоляции между клеммой питания и корпусом 20 МОм (50В постоянного тока)	
Выдерживаемое напряжение	1000 В переменного тока (50/60 Гц)	
Защита контура	Защита от переплюсовки, избыточного напряжения и короткого замыкания	
Рабочая температура	-25°C~+55°C (без наледи)	
Температура хранения	-30°C~ 70 (без наледи)	
Рабочая влажность	35~85% относительной влажности (без конденсации)	
Влажность хранения	35~95% относительной влажности (без конденсации)	
Внешнее освещение	Лампа накаливания 3000 люкс; светодиоды, S600 люкс; солнечный свет 10000 люкс	
Устойчивость к вибрации	10~50 Гц, амплитуда 0,5 мм, 2 часа по осям X/Y/Z	
Класс защиты	IP67	
Макс. момент затяжки	≤0.5Н	
Тип подключения	Разъём M8 4-пин	
Габариты	31*20*11 мм	
Материал	ПК+ АБС (корпус); ПММА (линза)	
Вес	Около 10 г	
Аксессуары	Отвертка, крепёж, винты и гайки	
NPN	ESB-BV30ANE	ESB-BY30ANE
PNP	ESB-BV30APE	ESB-BY30APE



Выход NPN



Выход PNP



SENSORS & sensing